Heusler 合金 Co₂TiSn 的磁性与输运性能*

张 炜¹) 千正男¹^{*} 隋 郁¹) 刘玉强¹) 苏文辉¹) 张 铭²) 柳祝红²) 刘国栋²) 吴光恒²)

1(哈尔滨工业大学凝聚态科学与技术中心 哈尔滨 150001)

2(中国科学院物理研究所磁学国家重点实验室,北京 100080)

(2004年12月14日收到2005年3月3日收到修改稿)

通过对 Heusler 合金 Co₂ TiSn 磁性和输运性能的实验研究 发现低场中 Co₂ TiSn 呈现出亚铁磁性 ;电阻和霍尔电 阻率在温度低于 8K 时均出现异常.同时分析了电输运的散射机制 ,并对反常霍尔效应产生的机制进行了探讨.

关键词:Heusler 合金,磁性,输运性能 PACC:7500,5225F

1.引 言

Heusler 合金是高度有序的三元金属间化合物, 具有立方 L21 结构 属于 Fm 3m 空间群 其一般化学 式为 X_2 YZ.由于其独特的输运、电性和磁性,Heusler 合金备受关注,在大多数 Heusler 合金中,磁矩主要 由 Y 原子提供.但是 就 Heusler 合金 Co, YZ 来说,X 位的 Co 原子的存在,情况有所不同.除了 Co, MnZ 之外 磁矩主要是由 Co 原子提供的. 与其他 X 位不 是 Co 原子的 Heusler 合金不同的是 ,Co, YZ 中 Co 原 子的磁矩随 Y 原子的不同而发生变化,磁矩值从 $0.3\mu_{\rm B}$ 变化到 $1.0\mu_{\rm B}^{[1]}$. Co 原子的磁矩对局域环境 有很强的依赖关系^[2]. Heusler 合金系列 Co, YSn(Y 为 Nb Ti 和 Zr 冲 Co 原子的最近邻为 Y 原子和 Sn 原子,不同的 Y 原子使它们的磁性不尽相同. Co2TiSn和 Co2ZrSn 的磁相变温度都高于 350K,而 Co,NbSn 的铁磁相变温度随样品不同而不同,在 100K 至 120K 间变化,从 2K 1.43 × 10⁶ A/m 的磁化 强度测量中估计的 Co2TiSn ,Co2ZrSn 和 Co2NbSn 每 分子的饱和磁矩分别为 1.96µB, 1.46µB 和 $0.69\mu_{B}^{[3]}$.其中 Co₂NbSn 是特别有趣的 结构相变温 度高于磁相变温度,即在顺磁相中,随着温度的下 降 "Co, NbSn 由立方 L21 结构变为正交结构或四方结 构.而且,不同样品的结构相变结束温度不同,在 200K 至 250K 间变化^[4-6]. Fuji 等人计算了它在低温 相和高温相的能带结构,得出结论:Jahn-Teller 效应 引起了晶格畸变,情形类似 Heusler 合金 $Ni_2MnGa^{[7\rightarrow 9]}$.相比而言, Co_2TiSn 和 Co_2ZrSn 除了磁 性外,在其他方面研究是很少的.本文将对 Co_2TiSn 的输运性能进行研究,同时还给出了磁性测量结果.

2. 实 验

样品由高纯度(99.9%)的金属(Co,Ti,Sn)按化 学配比称好后放入电弧炉水冷铜坩锅中反复熔炼. 将熔炼成的锭子,放在甩带机里,在氩气的保护下, 从熔融状态喷到高速旋转的Cu轮上,达到急速冷 却的效果.Cu轮的旋转速度是25m/s.室温x射线粉 末衍射证实样品为单相,为高度有序的L21结构(空 间群为Fm3m).进而由检索到的所有特征衍射峰, 计算得到了晶格参数 *a* 为 0.6052nm.美国 Quantum Design 公司生产的物性测量系统(Physical Property Measurement System,简称 PPMS)的 ACMS 和电阻选 项用来进行磁测量和电阻测量,ACT 选项用来测量 霍尔效应.电阻和霍尔效应都采用四端法进行测量.

3.结果和讨论

3.1.磁测量

图 1 是在不同温度 T 测定的 Co₂ TiSn 甩带样品的磁化曲线.可以看出当温度为 5K 时,磁化强度在

^{*}国家自然科学基金(批准号:10304004)及哈尔滨工业大学校基金(批准号:HIT2002.46)资助的课题。

[†]通讯联系人.E-mial:znqian@hit.edu.cn

 3.98×10^{5} A/m 以上的磁场作用下才开始趋于饱和, 表明样品的磁晶各向异性是很高的.外推得到的 0K 时的自发磁化强度 $M_{s}(0)$ 为 37.78(A·m²)/kg,经过 换算求得每分子的磁矩约为 $1.92\mu_{B}$.在 Co₂TiSn 中, Ti 原子提供磁矩非常小,可以忽略^[10],提供磁矩的 主要是 Co 原子.由此得到每个 Co 原子提供的磁矩 约为 0.96 μ_{B} 这和早期的测量结果是很相近的^[3].



图 1 Co₂TiSn 不同温度时的磁化曲线

Mohn 等人研究 Co₂TiSn 的磁性时发现 ,Co 原子 和 Ti 原子间的耦合是反平行的^[11].这个结果表明 , Co₂TiSn 具有亚铁磁基态.图 2 给出了 Co₂TiSn 在 7.96×10³ A/m 和 3.98×106A/m 磁场中的热磁曲线 , 从图中可以看出 ,用 7.96×10³ A/m 的外加磁场测量 时 ,没有破坏其亚铁磁性的排列. 而磁场升至 3.98 ×10⁶ A/m 时 ,基本上已经达到饱和状态.随着温度 的升高 ,原子的热运动加剧 ,原子磁矩的无序倾向增 大 ,导致磁化强度下降.另外 ,我们利用分子场理论 , 由热磁曲线的数据作 M^2 -T 曲线 ,再将曲线的线性 部分外推至 M^2 = 0 ,确定出 Co₂TiSn 的居里温度为 360K ,这和文献中报导的结果相同^[12].



图 2 Co₂TiSn 在不同外场作用下的磁化强度 *M* 和温度 *T* 的关 系曲线 插图为 *M*²-*T* 曲线

3.2. 输运测量

 $Co_2 TiSn$ 的整个电阻行为类似金属.剩余电阻比 率 $\rho_{300k}/\rho_{5K} \approx 1.4$ 表明了样品中残余应力或无序的 存在.电阻曲线最引人注意的特征是零场下低温电 阻出现明显的异常行为.如图 3 所示。电阻在温度 为 5K 达到最小值后出现急剧增加,7.2K 左右异常 行为结束.而在 1.59 × 10⁶ A/m 磁场中,低温异常行 为消失.



图 3 Co₂TiSn 电阻 *R* 和温度 *T* 的关系曲线 插图为低温的电阻 和温度的关系曲线

一般说来,铁磁材料的电阻率 ρ(T)有三种来
 源:

$$\rho(T) = \rho_{\rm r} + \rho_{\rm i}(T) + \rho_{\rm M}(T),$$
 (1)

这里 ρ_r 为剩余电阻率 , ρ_i (*T*)来自电声子散射 的贡献 ,低温时 ,电声子散射和 *T*⁵ 成比例 ;在顺磁 相内 ,随温度线性变化 . 而 ρ_M (*T*)主要来自电子-电 子散射和电子-磁子散射 ,就铁磁元素 Fe ,Co 和 Ni 来说 ,其电子-电子间的散射和 *T*² 是成正比的^[13], Watts 等人报道了电子-磁子散射也和 *T*² 成正比^[14].

为了分析电输运中的散射机制,根据 Matthiessen定则,我们将总电阻率分离为剩余电阻 率和与温度相关的部分:

$$\rho(T) = \rho_0 + \rho_1(T),$$
 (2)

假定实验数据遵循

$$\rho_L(T) = cT^n . \tag{3}$$

由 $\ln(\rho - \rho_0)$ 和 $\ln(T)$ 的关系可给出一条曲线, 曲线斜率对应于局域幂指数 n,如图 4 所示.

数据分析表明 ,35K < T < 315K 的温度范围内, n 值接近 2,可见电子与电子、电子与磁子间的作用 是主要的散射机制.而对于 10K < T < 35K,电阻变 化很小.电阻率和温度间的平方关系发生偏离,这可 能是由自旋波激发的过程中,能隙的出现引 起的^[15]。



图 4 $\ln(\rho - \rho_0)$ 和 $\ln T$ 的关系曲线 插图为局域幂指数 n 与温度 T 的关系

图 5 给出了 Co₂TiSn 霍尔效应的测量结果.在铁磁材料中,霍尔电阻率与外磁场不再是简单的线性关系.霍尔效应是由两部分贡献组成的,Hall 电阻率 _{0H} 写成

$$\rho_{\rm H} = \frac{E_{_{Y}}}{J_{_{X}}} = \mu_0 (R_0 H + R_{\rm S} M), \qquad (4)$$

$$p_{\rm H} = R_0 H + 4\pi R_{\rm S} M , \qquad (5)$$

其中, E_y 为横向霍尔电场, J_x 为纵向电流密度,第 一项是由电子受到洛伦兹力作用引起的正常霍尔效 应的电阻率,与外磁场 H 成正比, R_0 为正常霍尔系 数,第二项为反常霍尔效应的电阻率,与磁化强度 M 成正比, R_s 为反常霍尔系数.由于铁磁材料中存 在反常霍尔效应,极大的妨碍了对正常霍尔效应的 观察.但是,当 $R_s \gg R_0$ 时,可以利用霍尔电阻率和 磁场的关系曲线的斜率来求出 R_0 , R_s .

低场斜率
$$R_{
m H} = \left(\frac{\partial
ho_{
m H}}{\partial H}\right)_{H o 0} \cong R_{
m S}$$
, (6)

$$R_0 = (n_0 e)^{-1} , \qquad (8)$$

 $R_{\rm H} = \left(\frac{\partial \rho_{\rm H}}{\partial H}\right)_{\mu_{\rm ACC}} \simeq R_0$, (7)

可以确定载流子密度 n_0 和载流子类型 ,其中 e 为电子电荷.

从 Co₂TiSn 在不同温度时的霍尔电阻率和磁场的关系曲线中可以很容易地看出反常贡献的存在.

同时,温度为5K时的曲线和其他的曲线存在明显 不同.为了进一步明确霍尔电阻率在低温的变化细 节,我们测量了2K,3K,4K,5K,6K,7K,8K的霍尔电 阻率和磁场的关系曲线,如图6给出了低场部分的 测量结果.我们发现霍尔电阻率低温出现异常行为, 这种行为不但与温度有关,而且受磁场的影响也是 很大的.当温度为2K时,磁场高于7.96×10⁴A/m, 异常行为消失,随着温度升高,异常行为消失所需的 磁场越来越小,温度升到了7K后,异常行为产不零场 时已经完全消失了(如图6插图所示).这个温度接 近于零场下低温电阻急剧下降的温度,我们认为这 种异常行为是由超导杂质引起的.随着温度与磁场 的增加,超导态被破坏,异常行为消失.



图 5 $Co_2 TiSn$ 的霍尔电阻率 ρ_H 和磁场 H 的关系曲线

利用图 5 霍尔电阻率和磁场的关系曲线的高场 斜率,我们得到了 Co₂TiSn 的正常霍尔系数 R_0 .随着 温度的升高, R_0 的符号由正变到负,意味着由空穴 导电为主转变到电子导电为主.进而利用(8)式得出 了载流子浓度随温度的变化关系,如图 7 所示.其 中 SK时 $n_0 = 1.5962 \times 10^{28}$ /m³,此处载流子浓度 n_0 为空穴浓度和电子浓度的差值.

采用自由电子模型 利用

$$n_0 V_c = V_c / e R_0$$
 , (9)

得到每个原胞内的有效载流子数,其中 V_c为原胞体积.求得温度为 8K 时每原胞内有效载流子数为 3.48 个,这个值比电子和空穴同时存在时大.温度低于 130K 时,载流子数目变化不大.但是温度高于 130K 时,载流子增大了一个数量级,并且从 141K 到 142K 开始改变符号.表明此温度处电子结构发生了变化.

此外,在铁磁材料中,习惯上通过比较反常霍尔 系数(*R*_s)和零场电阻率(ρ_{xx})决定反常霍尔效应的



图 6 当温度从 2K 升至 8K 的霍尔电阻率 $\rho_{\rm H}$ 和磁场 H 的关系 曲线 插图为异常行为消失所需的磁场 H 和温度 T 的关系



图 7 载流子浓度 n₀ 和温度 T 的关系 插图为反常霍尔系数 R_s 和零场电阻 R 的关系

起源. *R*_s 取决于两种不同的机制 ,即经典的 Smit 斜 交散射和非经典输运(侧跃机制). *R*_s 和 ρ_{xx}的关系 可以写成: $R_{\rm S} = a\rho_{\rm xx} + b\rho_{\rm xx}^2$, (10)

其中 *a*,*b*为常数,第一项描述了斜交散射,即杂质 对载流子的散射,以霍尔角 ∳_{sk}(载流子轨迹的平均 偏斜的斜交散射角)为特征.第二项描述了非经典运 输机制,以传导电子在杂质中心散射前后的晶格横 向位移 Δy 为特征.

由图 7 插图给出的反常霍尔系数 R_s 和零场电 阻 R 的关系曲线 ,可进一步探讨 $Co_2 TiSn$ 中反常霍 尔效应产生的机制.其中 R_s 是利用图 5 中曲线的 低场斜率得到的.从图中可以看出 , R_s 为正值 ,且和 R 成正比 ,零场电阻 R 和零场电阻率 ρ_{xx} 相差一个常 数 ,因此可以认为 R_s 和零场电阻率 ρ_{xx} 是成正比的. 这个结果表明 , $Co_2 TiSn$ 的反常霍尔效应是由斜交散 射引起的 ,即磁性离子磁矩产生的磁场对移动的载 流子有作用 ,从而导致了反常霍尔效应^[16].

4.结 论

通过对 Co₂TiSn 的磁性及输运性能的研究发现,Co₂TiSn 具有亚铁磁基态,在一定磁场作用下,变为铁磁体.温度为 0K 饱和磁化强度为 37.78(A·m²)kg,居里温度为 360K.从输运性能上看,低温电阻和霍尔电阻率都出现异常行为,并且这种异常行为受温度和磁场的影响很大,分析表明低温输运行为可能是超导杂质引起的.Co₂TiSn 的电阻表现出金属行为 315K > T > 35K,磁散射为主要的散射机制. 霍尔效应测量表明了反常霍尔效应的存在,正常霍尔系数符号由正变负,表明了载流子类型的变化.反常霍尔系数和零场电阻率成正比,由此得出反常霍尔效应是由斜交散射引起的.

- [1] Ziebeck K R A and Webster P J 1974 J. Phys. Chem. Solid 1 35
- [2] Jezierski A 1996 Phys. Status. Solidi B 196 357
- [3] Engen P G , Buschow K H J and Erman M 1983 J. Magn. Magn. Mater 30 374
- [4] Terada M , Fujita Y and Endo K 1974 J. Phys. Soc. Jpn 36 620
- [5] Neumann K-U, Kanomata K, Ouladdiaf B et al 2002 J. Phys. Condens. Matter 14 1371
- $\left[\begin{array}{c} 6 \end{array} \right] \quad Yamasaki \ A \ , Imada \ S \ , Arai \ R \ et \ al \ 2002 \ Phys \ . \ Rev \ . \ B \ 65 \ 104410$
- [7] Brown P J, Bargami A Y, Crangle J et al 1999 J. Phys : Condens. Matter 11 4715
- [8] Gao S X, Wang W H, Liu Z H et al 2002 Acta Phys. Sin 51 332 (in Chinese] 高淑侠、王文洪、柳祝红等 2002 物理学报 51 332]

- [9] Wang W H, Liu Z H, Chen J L *et al* 2002 *Acta Phys*. *Sin* **51** 635 (in Chinese]王文洪、柳祝红、陈京兰等 2002 物理学报 **51** 635]
- [10] Ishida S, Akazawa S, Kubo Y et al 1982 J. Phys. F: Met. Phys 12 1111
- [11] Mohm P , Blaha P and Schwarz K 1983 J. Magn. Magn. Mater 140-144 183
- [12] Kido M , Ido H and Kido G 1992 J. Magn. Magn. Mater 104-107 705
- [13] Otto M J, van Woerden R A M and van der Valk P J 1989 J. Phys. Condens. Matter 1 2351
- [14] Watts S M, Wirth S, von Molnar S et al 2000 Phys. Rev. B 61 9621

Magnetism and transport properties of Heusler alloy Co2TiSn*

Zhang Wei¹) Qian Zheng-Nan¹[†] Sui Yu¹) Liu Yu-Qiang¹) Su Wen-Hui¹)

Zhang Ming²) Liu Zhu-Hong²) Liu Guo-Dong²) Wu Guang-Heng²)

¹⁾ (Center for Condensed Matter Science and Technology , Harbin Institute of Technology , Harbin 150001 , China)

² (State Key Laboratory of Magnetism , Institute of Physics , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100080 , China)

(Received 14 December 2004; revised manuscript received 3 March 2005)

Abstract

Magnetism and transport properties of the Heusler alloy Co_2 TiSn are studied. The results show this alloy exhibits ferrimagnetic structure at low field. Both resistance and Hall resistivity show anomalies below 8K. An analysis is given for the microscopic scattering mechanisms of electric transport. The origin of anomalous Hall effect is discussed.

Keywords : Heusler alloy , magnetism , transport properties PACC : 7500 , 5225F

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10304004) and the Scientific Research Foundation of Harbin Institute of Technology (Grant No. HIT. 2002.46).

[†]Corresponding author. E-mail : znqian@hit.edu.cn